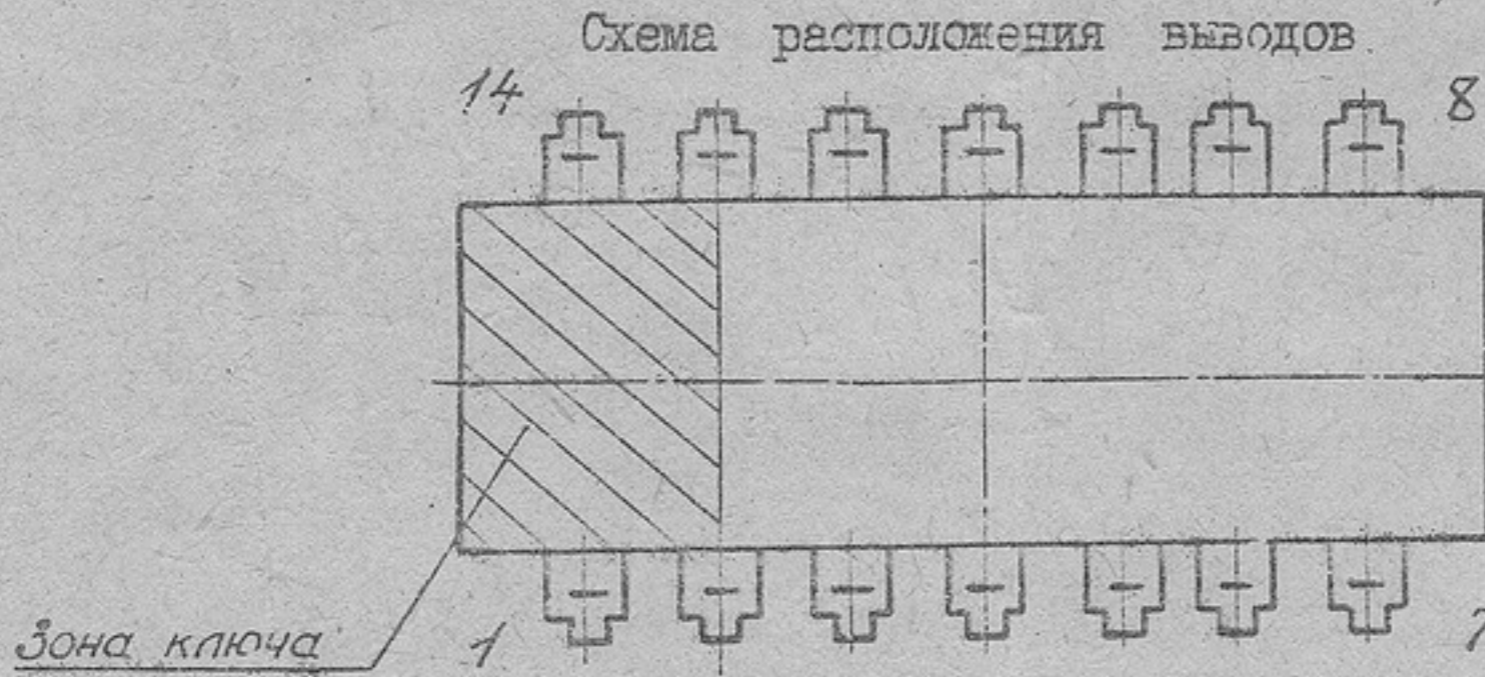




## Э Т И К Е Т К А

Микросхемы типа КР165ГФ2 соответствуют техническим условиям 6Ю.348.096-01 ТУ

Полупроводниковая интегральная микросхема представляет собой четырех-фазный генератор импульсов.



Масса не более 1,1 г.

Содержание драгметаллов в одной микросхеме

Золото \_\_\_\_\_

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Наименование вывода	Номер вывода	Наименование вывода	Номер вывода	Наименование вывода
1, 13	Регулировка частоты	6	Выход Ф2	10	Запрет Ф1
2	Выход Ф4	7	Выход стабилизатора	12	Выход Ф3
3, 4, 11	—	8	Питание	14	Общий
5	Запрет Ф2	9	Выход Ф1		

Примечание. При эксплуатации вывод 14 должен быть электрически соединен с выводами 4 или 11.

Основные электрические параметры при нормальных климатических условиях.

Наименование параметра, режим измерения единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
1. Выходное напряжение высокого уровня ( $U_{cc} = 24,3В$ ; $U_I = 2,0В$ ), В	$U_{OH}$	$U_{cc} - 0,6$	
2. Выходное напряжение низкого уровня ( $U_{cc} = 24,3В$ ; $U_I = 2,0В$ ), В	$U_{OL}$	—	1,0
3. Ток потребления ( $f_{clk} = 115кГц$ ; $C_{L13} = 950пф$ ; $C_{L24} = 300пф$ ; $U_{cc} = 297В$ ; $U_I = 2,0В$ ), мА	$I_{cc}$	—	12,0
4. Частота генерирования ( $U_{cc} = 27 \pm 10\% В$ ; $U_I = 2,0В$ ), кГц	$f_{clk}$	50	100
5. Уход частоты, %	$\Delta f_{clk}$	—	$\pm 15,0$
6. Время перекрытия фаз Ф1 и Ф2, Ф3 и Ф4, ( $U_{cc} = 24,3В$ ; $U_I = 2,0В$ ), мкс	$t_{p1,2}$ $t_{p3,4}$	1,1	—
7. Время сдвига спадов импульсов фаз Ф1 и Ф2, Ф3 и Ф4 ( $U_{cc} = 24,3В$ ; $U_I = 2,0В$ ), мкс	$t_{s1,2}$ $t_{s3,4}$	1,1	—



Наименование параметра, режим измерения единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
8. Интервал времени между импульсами Фаз $\Phi_2$ и $\Phi_4$ , $\Phi_4$ и $\Phi_2$ , ( $U_{cc} = 24,38$ ; $U_T = 2,08$ ) мкс	$t_{ц2-4}$ , $t_{ц4-2}$	0,1	—
9. Время перехода из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня ( $C_{L13} = 100$ пф; $C_{L13} = 950$ пф) мкс ( $C_{L24} = 300$ пф)	$t_{TLH1}$ ; $t_{TLH3}$	—	0,3 0,8
	$t_{TLH2}$ $t_{TLH4}$	—	0,4
10. Время перехода из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня ( $C_{L13} = 100$ пф; $C_{L13} = 950$ пф; $C_{L24} = 300$ пф) мкс	$t_{THL1}$ ; $t_{THL3}$	—	0,3 0,5
	$t_{THL2}$ ; $t_{THL4}$	—	0,3

